



Транзисторы КТ830А кремниевые мезаэпитаксиально-планарные структуры р-п-р. Предназначены для применения в усилителях мощности, источниках вторичного электропитания, преобразователях.

Корпус 2Т830А, 2Т830Б, 2Т830В, 2Т830Г металлический со стеклянными изоляторами и гибкими выводами, транзисторы 2Т830В-1, 2Т830Г-1 бескорпусные с защитным покрытием и гибкими выводами.

Масса транзистора в металлическом корпусе не более 2 г, бескорпусного - не более 0,03 г.

Основные технические характеристики транзистора КТ830А:

Структура транзистора: р-п-р;

$P_{к т max}$ - Постоянная рассеиваемая мощность коллектора с теплоотводом: 5 Вт;

$f_{гр}$ - Граничная частота коэффициента передачи тока транзистора для схемы с общим эмиттером: не менее 4 МГц;

$U_{кбо max}$ - Максимальное напряжение коллектор-база при заданном обратном токе коллектора и разомкнутой цепи эмиттера: 35 В;

$U_{эбо max}$ - Максимальное напряжение эмиттер-база при заданном обратном токе эмиттера и разомкнутой цепи коллектора: 5 В;

$I_{к max}$ - Максимально допустимый постоянный ток коллектора: 2 А;

$I_{к и max}$ - Максимально допустимый импульсный ток коллектора: 4 А;

$I_{кбо}$ - Обратный ток коллектора - ток через коллекторный переход при заданном обратном напряжении коллектор-база и разомкнутом выводе эмиттера: не более 100 мкА (35В);

$h_{21э}$ - Статический коэффициент передачи тока транзистора для схем с общим эмиттером: более 20;

$R_{кэ нас}$ - Сопротивление насыщения между коллектором и эмиттером: не более 1,2 Ом